



2SC2411K (3DG2411K)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

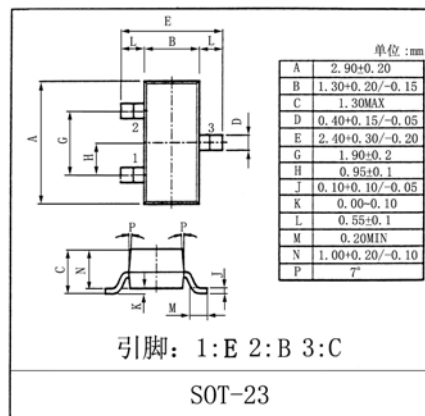
用途:用于中功率放大。/Purpose: Medium power amplifier applications.

特点:集电极直流电流大, 饱和压降低, 与 2SA1036K (3CG1036K) 互补。

Features: Large I_C , low $V_{CE(sat)}$, complementary pair with the 2SA1036K (3CG1036K).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	32	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	500	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



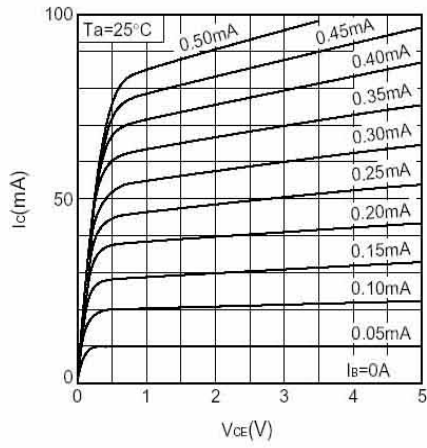
电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=100\mu\text{A}$	40			V
V_{CE0}	$I_C=1.0\text{mA}$	32			V
V_{EB0}	$I_E=100\mu\text{A}$	5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=20\text{V}$			1.0	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=4.0\text{V}$			1.0	μA
h_{FE}	$V_{CE}=3.0\text{V}$ $I_C=10\text{mA}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=10\text{mA}$			0.4	V
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}$ $I_E=-20\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$		250		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		6.0		pF

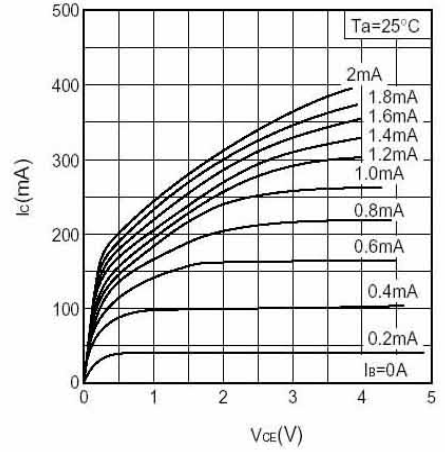
h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	P	Q	R
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	82~180	120~270	180~390
印章 Marking	HCP	HCQ	HCR

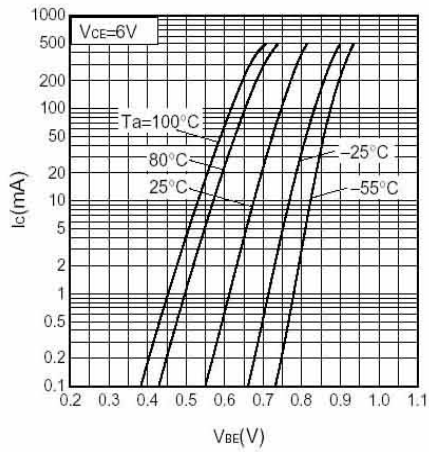
$I_C - V_{CE}$



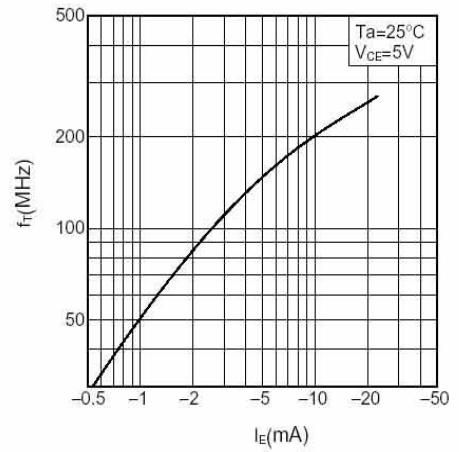
$I_C - V_{CE}$



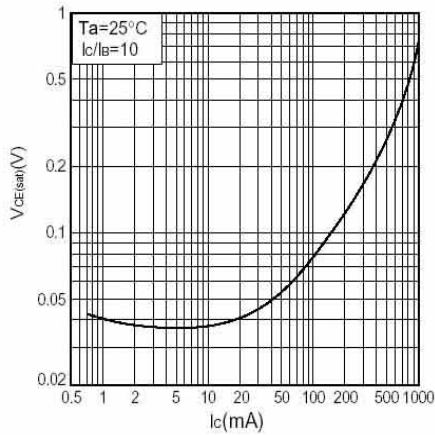
$I_C - V_{BE}$



$f_T - I_E$



$V_{CE(sat)} - I_C$



$h_{FE} - I_C$

